Docket No.

Declaration and Power of Attorney for U.S. Patent Application

特許出願宣言書及び委任状

Japanese Language Declaration

日本語宣言書

下***の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言します。	As a below named inventor, I hereby declare that:
私の住所、私書箱、国籍は下記の私の氏名の後に記載された通りです。	My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.
下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出願している発明内容について、私が最初かつ唯一の発明者(下記の氏名が一つの場合)もしくは最初かつ共同発明者であると(下記の名称が複数の場合)信じています。	I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled
	SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD
	OF MANUFACTURING THE SAME
ト記発明の明細書(下記の欄でx印がついていない場合は、 本書に添付)は、	the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:
□ 月 日に提出され、米国出願番号または特許協定条約 国際出願番号をとし、 (該当する場合) に訂正されました。	was filed on as United States Application Number or PCT International Application Number and was amended on (if applicable).
私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、	
内容を理解していることをここに表明します。	I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.
内容を理解していることをここに表明します。 私は、連邦規則法典第37編第1条56項に定義されると おり、特許資格の有無について重要な情報を開示する義務が あることを認めます。	the above identified specification, including the claims, as

HATTORI, McLELAND & NAUGHTON

Japanese Language Declaration

(日本語宣言書)

私は、米国法典第35編119条 (a) - (d) 項又は365条 (b) 項に基き下記の、 米 国以外の国の少なくとも一ヵ国を指 定している特許協力条約 3 6 5 (a) 項に基ずく国際出願、又 は外国での特許出願もしくは発明者証の出願についての外国 優先権をここに主張するとともに、優先権を主張している、 本出願の前に出願された特許または発明者証の外国出願を以 下に、枠内をマークすることで、示しています。

Prior Foreign Application(s)

外国での先行出類 Japan 11–140346 (Country) (Number) (国名) (番号) (Country) (Number) (闰名) (番号)

私に、第35編米国法典119条 (e) 項に基いて下記の米 国特許出願規定に記載された権利をここに主張いたします。

> (Filing Date) (Application No.) (出類日) (出願番号)

私は、下記の米国法典第35編120条に基いて下記の米 国特許出願に記載された権利、 又は米国を指定している特許 協力条約365条 (c) に基ずく権利をここに主張します。ま た、本出願の各請求範囲の内容が米国法典第35編112条 第1項又は特許協力条約で規定された方法で先行する米国特 許出額に開示されていない限り、その先行米国出願書提出日 以降で本出願書の日本国内または特許協力条約国際提出日ま での期間中に入手された、連邦規則法典第37編1条56項 で定義された特許資格の有無に関する重要な情報について開 示義務があることを認識しています。

(Filing Date) (Application No.) (出願番号) (出願日) (Application No.) (Filing Date) (出願各号) (出類日)

私は、私自身の知識に基ずいて本宣言書中で私が行なう表 明が真実であり、かつ私の入手した情報と私の信じるところ に基ずく芸明が全て真実であると信じていること、さらに故 意になされた虚偽の表明及びそれと同等の行為は米国法典第 18編第1001条に基ずき、罰金または拘禁、もしくはそ の両方により処罰されること、そしてそのような故意による 虚偽の声明を行なえば、出願した、又は既に許可された特許 の有効性が失われることを認識し、よってここに上記のごと く宣誓を致します。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119 (a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Priority Not Claimed 優先権主張なし

May 20, 1999 (Day/Month/Year Filed) (出願年月日) (Day/Month/Year Filed) (出類年月日)

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

> (Filing Date) (Application No.) (出類日) (出願番号)

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 120 of any United States application(s), or 365(c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code Section 112, 1 acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of application.

> (Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況: 特許許可済、係属中、放棄済)

(Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況: 特許許可済、係属中、故薬済)

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Japanese Language Declaration (日本語宣言書)

私は下記の発明者として、本出類に関する一切の 委任:状: 手続きを米特許商標局に対して遂行する弁理士または代理人 として、下記の者を指名いたします。(弁護上、または代理 人の氏名及び登録番号を明記のこと)

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith (list name and registration number) See list of attorneys and/or agents on page 5.

書類送付先

Send Correspondence to:

ARMSTRONG, WESTERMAN, HATTORI, McLELAND & NAUGHTON 1725 K Street, N.W., Suite 1000 Washington, D.C. 20006

直接電話連絡先: (名前及び電話番号)

2

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

Telephone: (202) 659-2930 Fax: (202) 887-0357

唯一または第一発明者	7名	Full name of sole or first inventor Toshikazu INOUE
発明者の署名	日付	Inventor's signature Date Toshikagu I noul November 4, 1999
住所		Residence
		Aizuwakamatsu-shi, Fukushima Japan
国籍		Citizenship Japan
私書箱		Post Office Address c/o FUJITSU AMD SEMICONDUCTOR LIMITED, 6, Kogyodanchi,
	,	Mondenmachi, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima 965—0845 Japan
第二共同発明者		Full name of second joint inventor, if any Tadashi KINOSHITA
第二共同発明者	日付	Second inventor's signature Date Jackshi Hingshita November 4, 1999
住所		Residence Aizuwakamatsu—shi, Fukushima Japan
国籍		Citizenship Japan
私書箱		Post Office Address c/o FUJITSU AMD SEMICONDUCTOR LIMITED, 6, Kogyodanchi,
		Mondenmachi, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima 965-0845 Japan

(第三以降の共同発明者についても同様に記載し、署名をす ること)

(Supply similar information and signature for third and subsequent joint inventors.)

†		·
私書新		Post Office Address .
国 存		Citizenship
住所		Residence
第六発明者の署名	日付	Sixth Inventor's signature Date
第六共同発明者		Full name of sixth joint inventor, if any
		Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan
	<u> </u>	Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku,
私艺箱	-	Japan Post Office Address C/O FUJITSU LIMITED, 1-1,
国籍		Citizenship
		Kawasaki-shi, Kanagawa Japan
第五発明者の署名 (住所	日付	Fifth inventor's signature Pronto Shiohma November 4, 1999 Residence
		Full name of fifth joint inventor, if any Morio SHIOHARA
第五共同発明者		Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan
#	·	Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku,
私否布		Japan Post Office Address C/O FUJITSU LIMITED, 1-1,
宣 稱		Citizenship
主所		Residence Kawasaki-shi, Kanagawa Japan
第四発明者の署名 	日付	Fourth inventor's signature Date Shun-ichi Hukuyama November 4, 1999
↑第四共同発明者 		Full name of fourth joint Inventor, If any Shun-ichi FUKUYAMA
	·	Mondenmachi, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima 965-0845 Japan
1 and Sept. 4782		SEMICONDUCTOR LIMITED, 6, Kogyodanchi,
私志知		Japan Post Office Address C/O FUJITSU AMD
国开		Citizenship
住所		Aizuwakamatsu—shi, Fukushima Japan
第三発明者の署名	日付	Third inventor's signature Ramutoshi Mochiyulu' November 4, 1999 Residence
		Kazutoshi MOCHIZUKI
第三共同発明者		Full name of third joint inventor, if any

Docket No.

List of attorneys and/or agents

James E. Armstrong, III, Reg. No. 18,366; William F. Westerman, Reg. No. 29,988; Ken-Ichi Hattori, Reg. No. 32,861; Le-Nhung McLeland, Reg. No. 31,541; Ronald F. Naughton, Reg. No. 24,616; John R. Pegan, Reg. No. 18,069; William G. Kratz, Jr., Reg. No. 22,631; James P. Welch, Reg. No. 17,379; Albert Tockman, Reg. No. 19,722; Mel R. Quintos, Reg. No. 31,898; Donald W. Hanson, Reg. No. 27,133; Stephen G. Adrian, Reg. No. 32,878; William L. Brooks, Reg. No. 34,129; John F. Carney, Reg. No. 20,276; Edward F. Welsh, Reg. No. 22,455; Patrick D. Muir, Reg. No. 37,403; Gay A. Spahn, Reg. No. 34,978; John P. Kong, Reg. No. 40,054; and Luke A. Kilyk, Reg. No. 33,251.